

**СВЕДЕНИЯ
о ведущей организации**

Полное наименование организации, сокращенное наименование организации	Место нахождения (страна, город)	Почтовый адрес (индекс, город, улица, дом), телефон (при наличии); адрес электронной почты (при наличии), адрес официального сайта в сети "Интернет" (при наличии)
Федеральное государственное автономное научное учреждение Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники имени В.Г. Мокерова Российской академии наук, ИСВЧПЭ РАН	Россия, г. Москва	117105, г. Москва, Нагорный проезд д. 7, стр. 5 тел. 8 (499) 123-44-64 E-mail: isvch@isvch.ru www.isvch.ru

Список основных публикаций работников ведущей организации по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций):

1. Исследование полимерных нитей с наноостровковой топологией наногетероструктур алюминия / П. П. Мальцев, А. А. Ганжа, В. Ю. Павлов [и др.] // Нано- и микросистемная техника. – 2023. – Т. 25, № 5. – С. 203-209.
2. Исследование потерь пропускания в поликристаллическом CVD-алмазе в миллиметровом диапазоне длин волн методом свободного пространства / Д. Л. Гнатюк, А. В. Зуев, Д. В. Крапухин [и др.] // Письма в Журнал технической физики. – 2021. – Т. 47, № 18. – С. 43-46.
3. Мишина, Е. Д. Новые материалы и структуры для эффективной терагерцовой спектроскопии / Е. Д. Мишина, А. М. Буряков, Д. С. Пономарев // Радиотехника и электроника. – 2021. – Т. 66, № 9. – С. 891-900.
4. Исследование морфологии поверхности, электрофизических характеристик и спектров фотолюминесценции эпитаксиальных плёнок GaAs на подложках GaAs (110) / Г. Б. Галиев, Е. А. Климов, А. А. Зайцев [и др.] // Оптика и спектроскопия. – 2020. – Т. 128, № 7. – С. 877-884.
5. Электрофизические и фотолюминесцентные исследования сверхрешеток \LT-GaAs/GaAs : Si\, выращенных методом молекулярно-лучевой эпитаксии на подложках GaAs с ориентацией (100) и (111)A / Г. Б. Галиев, Е. А. Климов, А. Н. Клочков [и др.] // Физика и техника полупроводников. – 2019. – Т. 53, № 2. – С. 258-266. .

Директор ИСВЧПЭ РАН
профессор, д.т.н.



С.А. Гамкрелидзе